

2SC2561

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Epitaxial Planar

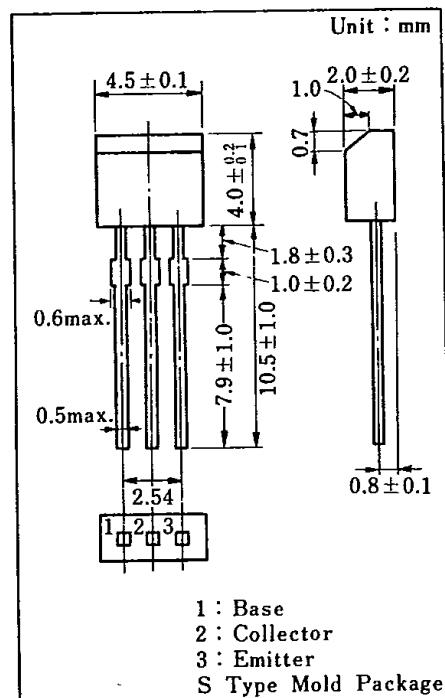
高周波増幅用 / RF Amplifier

■ 特 徴 / Features

- FM/AM ラジオの RF 増幅に最適です。 / Suitable for RF Amplifier in FM/AM radios
- トランジション周波数 f_T が高い。 / High f_T

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	30	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	20	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	30	mA
コレクタ損失	P_C	250	mW
接合部温度	T_J	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +125$	$^\circ\text{C}$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 10\text{ V}, I_E = 0$			0.1	μA
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$V_{CB} = 10\text{ V}, I_C = 1\text{ mA}$	50		220	
トランジション周波数	f_T	$V_{CB} = 10\text{ V}, I_C = 1\text{ mA}$	150	250		MHz
雑音指数	NF	$V_{CB} = 10\text{ V}, -I_E = 1\text{ mA}, f = 5\text{ MHz}$		2.8	4	dB
帰還容量	C_{re}	$V_{CB} = 10\text{ V}, -I_E = 1\text{ mA}, f = 10.7\text{ MHz}$		0.9	1.5	pF
帰還インピーダンス	Z_{rb}	$V_{CB} = 10\text{ V}, -I_E = 1\text{ mA}, f = 2\text{ MHz}$		22	50	Ω

* h_{FE} ランク分類 / h_{FE} Classifications

Class	A	B	C
h_{FE}	50~100	70~140	110~220

